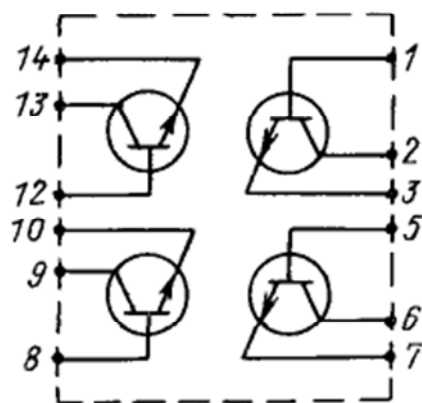
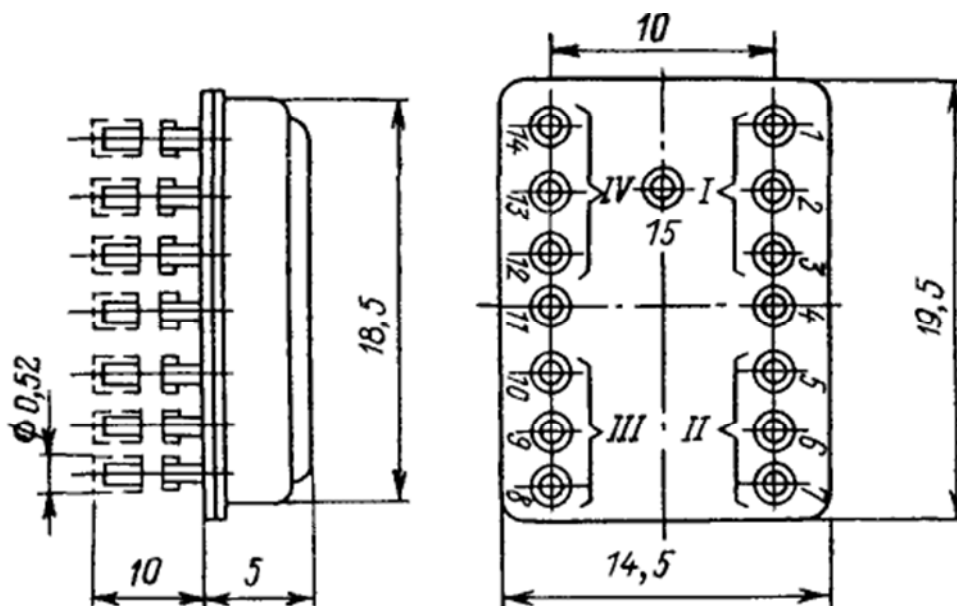


ТРАНЗИСТОРНАЯ СБОРКА КТС613

Транзисторные матрицы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п переключательные. Предназначены для быстродействующих импульсных схем. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Матрица содержит четыре изолированные транзисторные структуры. Масса матрицы не более 4 г



Цоколевка транзисторной сборки КТС613

Обозначение выводов:

- 1, 5, 8, 12 — база
- 2, 6, 9, 13 — коллектор
- 3, 7, 10, 14 — эмиттер
- 15 — корпус
- 4, 11 — свободный

Основные технические характеристики транзисторной сборки КТС613Б

- Структура транзисторной сборки: n-p-n;
- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 800 мВт;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 200 МГц;
- $U_{кбо\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 60 В;
- $U_{эбо\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
- $I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 400 мА;
- $I_{к\text{ и }t\max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 800 мА;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 8 мкА (60В);
- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 40... 200;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 15 пФ;
- $R_{кэ\text{ нас}}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 2,5 Ом;
- $t_{рас}$ - Время рассасывания: не более 100 нс